## 性能特点

●高精度 MEMS 微纳米加工

●高性能、全屏蔽、抗干扰微型腔体滤波器

●硅基片、50Ω 共面波导输出

●金丝键合，适用于多芯片集成模块应用

## 环境参数

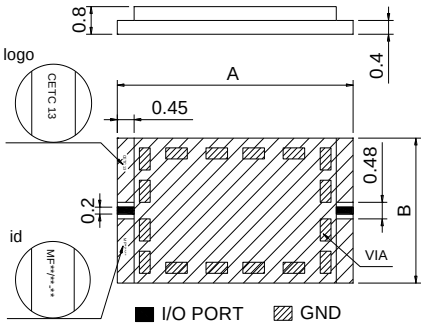
| | |
|---|---|
| 工作温度 | -55℃~+85℃ |
| 存储温度 | -55℃~+125℃ |
| 最高输入功率 | 35dBm |

## 电特性($T_A$=+25℃)

| 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 中心频率($f_0$) | - | 12.0 | - | GHz |
| 通带频率范围 | 10.9 | - | 13.1 | GHz |
| 带内波动 | - | - | 1 | dB |
| 中心插损 | - | - | 1.6 | dB |
| 回波损耗 | 15 | - | - | dB |
| 带外衰减 | ≥40@DC~9.4GHz | | | dB |
| | ≥40@14.2~20GHz | | | dB |
| 时延波动 | ≤1.2@PassBand | | | ns |
| 线性相位 | ≤±10@ PassBand | | | ° |

S2P 文件名：SiMF12_2R2-7D2.s2p

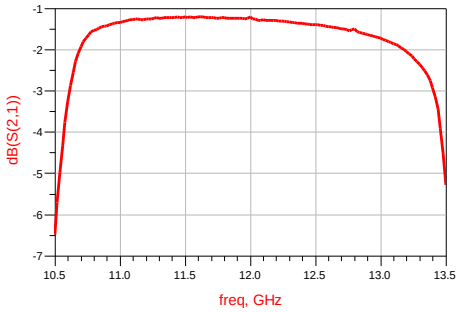
## 外形尺寸



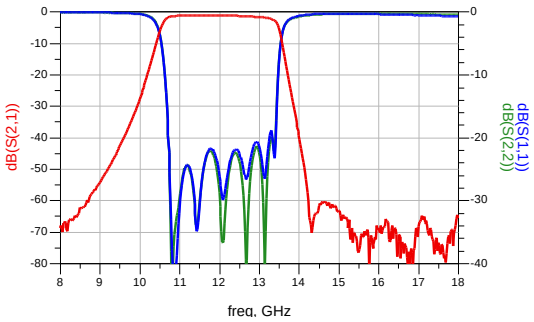

| 尺寸符号 | 数值(mm) | | |
|---|---|---|---|
| | 最小值 | 公称值 | 最大值 |
| A | | | |
| B | | | |

## 典型测试曲线

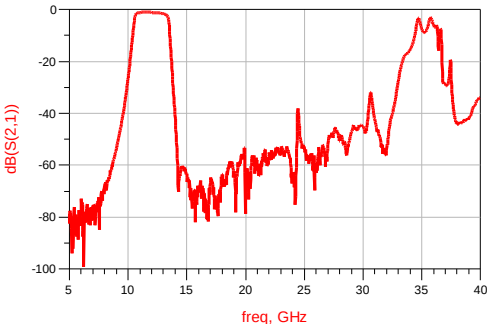
通带损耗 VS 频率($T_A$=25℃)



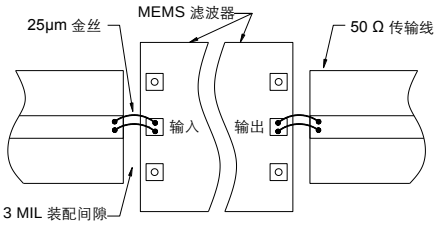

带外抑制 & 回波损耗 VS 频率($T_A$=25℃)




远端抑制 VS 频率($T_A$=25℃)

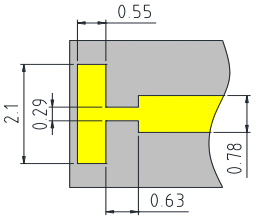
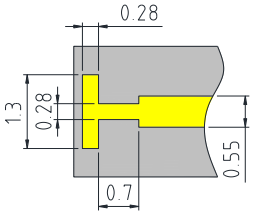



## 建议装配图




## 注意事项：

1. 芯片建议分腔使用，两侧距侧壁 0.2mm，表面距上盖 3mm，芯片端口可互换；
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与硅热膨胀系数(2.9ppm/℃)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配，T 型尺寸如下：

| 电路板 Rogers 5880，10mil 厚 | 电路板 Rogers 4350，10mil 厚 |
|---|---|
|  |  |



注：T 型图形顶端基板白边 0.1mm；频率 10GHz 以下无需匹配

5. 有问题请与供货商联系。

返回选型目录